

## ZrO<sub>2</sub> (Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 계 세라믹스의 소결성과 전기전도도에 대한 M<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 영향(I) : ZrO<sub>2</sub> - Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 계 세라믹스

오영제 · 정형진 · 이희수 \*

한국과학기술원 무기재료연구실

\*연세대학교 유풍공학과

(1986년 1월 29일 접수)

## Effect of M<sub>2</sub>O<sub>3</sub> on the Sinterability and Electrical Conductivity of ZrO<sub>2</sub> (Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) System (I) : Ceramics of the ZrO<sub>2</sub> - Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> System

Young-Jei Oh, Hyung-Jin Jung and Hee-Soo Lee \*

Inorganic Materials Lab., KAIST

\*Dept. of Ceramic Engineering, Yonsei University

(Received February 6, 1986)

### ABSTRACT

Yttria - bismuth - stabilized zirconia was investigated with respect to the amount of Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> addition in the range of 0.5 ~ 5 mol % to the base composition of (ZrO<sub>2</sub>)<sub>0.92</sub> (Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>0.08</sub>. Bismuth was introduced into the material with Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - SiO<sub>2</sub> glasses in order to reduce the evaporation of components.

The sinterability, evaporation of components, phase formation and microstructure were evaluated depending on the amount of Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - SiO<sub>2</sub> glass addition.

Two probe A. C. conductivity measurement was subjected to all the specimens and the result was discussed on the possible substitution of Bi<sup>3+</sup> for Zr<sup>4+</sup> and interstitial Si<sup>4+</sup> in the fluorite structure of zirconia crystal thereupon the possible change in the capability of oxygen transference within the material.

It was found that the addition of Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> could improve the sinterability of material very much while not so much degrading their electrical properties in a certain limit of Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - SiO<sub>2</sub> glass addition so as to be usable as an oxygen sensing material suitable for relative low temperature firing.

### I. 서 론

고순도의 안정화지르코니아는 약 1,630° ~ 1,730°C 온도에서의 급격한 입자성장 때문에 소결의 치밀화가 어려울 뿐만 아니라 약 600°C 이하의 저온에서의 전도도가 비교적 낮다. 따라서 입자성장 억제제로 SiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 및 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 등을 가하여 치밀화를 기하고 있다.<sup>1-2</sup> 이때 치밀화는 액상기구에 의하지만 소결온도는 여전히 1,500°C 정도로 높은 편이다.

Takahashi 등은<sup>3-7</sup> 소결온도가 보다 낮으면서도 (< 630°C) 저온에서의 전도도가 안정화지르코니아에 비하여 수배나 큰 안정화-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>계 전해질의 이온전도성에 대하여 보고하고 있다. 그러나 이제의 산소해리압은 약 730°C에서 10<sup>-5</sup> Pa 이여서 이온도 이상에서는 부식성때문에 백금전극등에 비교적 빨리 반응하므로 고온사용시 이제의 환원성과 부식성을 문제점으로 지적하고 있다.<sup>6,8)</sup>

따라서 Burggraaf 등은<sup>9-10</sup> 안정화-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 저온 소

결성과 고전도성 및 안정화지르코니아의 부식저항성과 저 산소해 터압(약 730 °C에서 < 10<sup>-3</sup> Pa) 등의 장점을 연관시킨 목적으로 ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>계에 대하여 연구한 바 있으나 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 심한 휘발성 때문에 일정한 조성의 ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>계 세라믹스를 얻지 못하였다.

본보는 ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>계 고용체에서의 최대의 전도도를 보유하는 8m/o Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-ZrO<sub>2</sub> 조성에<sup>11)</sup> Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 성분을 가하여 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 휘발성 억제를 위하여 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>계 유리상으로 첨가한 액상소결체에 대한 전기적 성질과 미세구조를 조사하여 저온소성용 산소제서 및 연료전지에 대한 적용성을 규명함을 목적으로 한다.

## II. 실험

### II-1. 출발 물질

최대의 전기전도도를 보유하는<sup>11)</sup> (ZrO<sub>2</sub>)<sub>0.95</sub>(Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>0.05</sub>(이하 ZY8로 약기함, Toyo-Soda계) 분말을 기본물질로 하였다. 분말 특성은 Table 1과 같으며 입방정상의 완전안정화 지르코니아임을 XRD로서 확인하였다. 유리재조용으로 3N의 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(Aldrich계)와 SiO<sub>2</sub>(Junsei계)의 특급시약을 사용하였다.

Table 1. Properties of the ZY8 Powder as Fundamental Starting Material.

Chemical analysis (w/o)						Crystal lite size (Å)	Specific surface area(m <sup>2</sup> /g)
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> O	IgLoss	200	23
13.25	0.077	0.007	0.006	0.006	0.5		

### II-2. 유리 제조

Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 취급양은 ZY8의 0.5, 1, 2, 3, 4 및 5m/o이며 여기에 SiO<sub>2</sub>를 ZY8 양의 0.33 w/o를 균일히 가하여 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>계 조합물을 조제하였다. 각 배치는 알루미나 도가니 내에서 1,000~1,100 °C, 1시간 정도에서 용융시켜 강판에 유틀 굽맹시킨 다음 미분쇄하여 325 메시 통과분만을 취하였다. 유리전이온도는 DTA결과 490~580 °C 범위내에서 실리케 할량 증가에 따라 상승하였다.

### II-3. 시편 계작

각 조합물은 폴리에틸렌 용기내에서 에탄을 존재하여 충분히 습식 혼합시킨 다음 적외선 전조를 하였다. 이를 원판형으로 일차 일축가압성형 한뒤 140MPa로 재차 등압성형하였다. 소성은 예비실험에서 설정한 1,300 °C, 4시간의 조건으로 실리코나트 가마에서 행하였다. 산소이온수송률 측정용 시편은 30mm × 3mm로,

전기전도도 측정용 시편은 11mm × 4~5mm로 하였다.

### II-4. 측정 및 관찰

#### (1) 기본특성

KS 규격에<sup>12)</sup> 따라 밀도와 흡수율을 측정하였으며, XRD는 CuK $\alpha$  방사선을 이용하여 주사속도 2θ/min = 1°/min로서 수행하였다. 격자상수 산출을 위하여 고작도 부분의 (331)과 (420)을 이용하였으며 주사속도는 1°/min으로 하였다. 소결시편의 잔존 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 함량은 시편을 HF 처리하여 실리케 성분을 제거시킨 뒤 잔분을 염산에 용해시켜 AA 법으로 정량하였다. 10 °C/min의 가열속도로 DTA/TGA의 열분석을 하였다. 시편을 열마한 뒤 필요한 경우 부식시켜 EDAX장착의 SEM (ISI DS-130)으로 2차상의 생성여부 등 미세구조를 관찰하였으며 이 때 입자크기는 Mendelson 법으로<sup>13)</sup> 구하였다.

#### (2) 전기전도도

시편 양단에 백금전극을 형성한 뒤 LF Impedance Analyzer (HP 4192A)를 이용하여 1kHz에 대한 공기 불위기하의 전기전도도를 500~1,000 °C 범위에서 50 °C 간격으로 측정하여 각 온도에서의 열평형을 유지시킨 다음 측정하였다. 이 때 측정가마내 발열체의 통전으로서 형성될 전자장과 시편을 차폐시키기 위하여 skin depth가 짧은 니켈판으로 시편을 보호한 뒤 겹지하였다.

#### (3) 산소이온수송률

산소이온수송률은 기전력법에<sup>14)</sup> 의하여 측정하였다. 이 때 수직형의 기체송출장치를<sup>15)</sup> 설치한 뒤, 시편과 기체송출용 석영유리판 사이에 Au O-Ring을 끼워 기체의 유출을 방지하였다. 시편 양단에는 다공성의 백금촉매전극을 형성하여 산소기체의 이온화를 도모하였다. O<sub>2</sub>-Ar 혼합기체를 이용하여 산소분압을 조절하였으며 공기를 표준산소분압으로 하였다. 혼합기체의 유속은 20 cm/sec로 하였으며 혼합기체는 미리 예열시키지는 않았지만 기전력 측정전에 시편과 주위 불위기가 각 온도에서 열평형이 이루어진 다음에 500~1,000 °C의 온도 범위에서 측정하였다.

## III. 결과 및 고찰

### III-1. 기본 특성

결과치는 Table 2와 같다. ZYB계에서, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 합물(유리상으로 첨가)이 증가할수록 밀도는 감소하여 그 중 ZYBO시편은 단미(ZY8)보다 밀도가 크다. 한편 기공률은 단미에 비하여 ZYB계 모두 월등한 감소를 보였다. 따라서 유리상 첨가는 ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>산화물의 소결온도를 약 300 °C 저하시켰으며 또한 보다 치밀한

Table 2. Physical Properties of the Samples

Item Sample No.	Composition			Apparent density(g/cm <sup>3</sup> )	Apparent porosity (%)	Grain size (μm)	Lattice Constant( nm)
	(ZrO <sub>2</sub> ) <sub>0.92</sub> (Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) <sub>0.08</sub> (m/o)	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (m/o)	SiO <sub>2</sub> (w/o)				
ZY8	100	-	-	5.81	3.01	2.6	0.5138
ZYB0	99.5	0.5	0.33	5.88	0.16	3.9	0.5141
ZYB1	99.0	1.0	0.33	5.75	0.12	4.7	0.5147
ZYB2	98.0	2.0	0.33	5.53	0.20	4.3	0.5148
ZYB3	97.0	3.0	0.33	5.30	0.27	3.6	0.5147
ZYB4	96.0	4.0	0.33	5.24	0.26	3.4	0.5153
ZYB5	95.0	5.0	0.33	5.22	0.17	3.4	0.5153
ZYS	100	-	0.33	5.84	0.18	-	0.5140
ZY8 a*	100	-	-	5.77	0.19	4.6	-
(ZrO <sub>2</sub> ) <sub>0.96</sub> (Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) <sub>0.04</sub> (Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) <sub>0.5</sub> **				5.68	-	10.15	0.5145

\* fired at 1,600°C for 4 hrs \*\* ref # 9.

소결을 가능케 하였다. 이것은 다음과 같은 점으로 보아 유리에 존재하는 Bi<sup>3+</sup>의 일부 휘발과 이로 인한 Bi<sup>3+</sup>의 높은 반응성에 기인된다고 생각된다.

즉, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>는 유리형성에 있어 느슨한 extended structure형을 이루게 한다는 Rawson의<sup>13)</sup> 보고와 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> 유리형성시 Si<sup>4+</sup>와 Bi<sup>3+</sup>이 distorted BiO<sub>6</sub> octahedra에 의해 포위되어 있다고 하는 Rao의<sup>14)</sup> 보고등으로 미루어 볼 때 Bi<sup>3+</sup>이 용이하게 휘발될 수 있으리라 보는데 실제 Table 3에서 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>는 일부 휘발되었으며, 또 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>는 ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 삼성분계의 소결 중 감소되었는데 이로 인한 reactive phase의 출현이 소결을 촉진시켜 주았다는 Keizer 등의<sup>15)</sup> 보고와도 잘

일치되는 점이다.

소성간량 결과를 표시한 Table 3에서 보는 바와 같이 시편내의 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 함량에 대한 이론치와 AA에 의한 실측치와의 차이는 전체무게 감량의 차와 일치하고 있지 않다. 이는 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 유리화 하였을지라도 역시 약간의 휘발을 면치 못함을 알 수 있는데, 다만 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 형태보다는 Bi<sup>3+</sup> 형태로 휘발하기 때문에 남아있는 산소가 전체무게 감량을 감소시켜주는 역할을 한것으로 생각된다.

그중 ZYB5의 경우를 보면, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 SiO<sub>2</sub>로 유리화 하였을때에는 5.5 w/o의 전체무게 감량을 보였으나 예비실험 결과 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 단독으로 첨가하였을 때에는 약 14.3 w/o의 전체무게 감량을 보여 결국 유리화로서의 첨가는 실제 60% 정도의 무게감량 억제효과를 나타낼 수 있었다.(ZYB0의 경우 약 80%이었음) 그러나 소정의 온도로 일단 소결된 분말의 DTA/TGA 열분석 결과 1,000 °C까지는 발열 또는 흡열파크나 무게감량도 없었으므로 실제 산소센서로 사용시 상기 온도내에서는 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 휘발에 의한 문제점은 없을 것으로 추측된다.

XRD 결과 ZYB계 시편은 Keizer 등이<sup>15)</sup> ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>계에 대하여 보고한 단사정 ZrO<sub>2</sub>의 출현과는 달리 모두 형석형 입방정상 퍼크만이 검출되었으며 격자상수는 단면에 비하여 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 함량이 증가할수록 대체적으로 증가 추세를 보였는데 이는 유리중에서 유리된 Bi<sup>3+</sup>가 Zr<sup>4+</sup> 또는 Y<sup>3+</sup>보다 이온반지름이 크므로 입방정 격자내에 용해되어 있음을 의미하나 이것의 pa-

Table 3. Weight Loss and Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Content of the Specimens Fired at 1,300°C for 4 hrs.

(W/O)

Item Samples	Total weight loss	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> content remained		
		Calculated	Observed	Defference
ZY8	1.4	-	-	-
ZYB0	1.8	1.74	1.25	-0.49
ZYB1	1.9	3.45	2.40	-1.05
ZYB2	3.2	6.73	4.29	-2.44
ZYB3	4.2	9.85	5.74	-4.11
ZYB4	4.8	12.83	7.00	-5.83
ZYB5	5.5	15.68	8.84	-6.84

parameter 가 Vegard's law에 따르지 않는 것은 Bi<sup>3+</sup>의 일부 휘발때문이라고 여겨진다.

Table 2에서 보면 시편의 평균임경은 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 함량이 0.5, 1 m/o (ZYB0, ZYB1)까지는 증가하다가 2.0 m/o 부터는 감소하였는데 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 만을 단독으로 첨가하였을 때 보다 입자성장이 상당히 억제되었다. Fig.1의 SEM 사진에서 보듯이 단미의 것은 완전안정화 지르코니아 소결체에서 전형적으로 나타나는 transgranular 한 패턴을 보이나, 유리첨가의 예상소결의 것은 intergranular 한 형상을 보여주고 있다. 특히 5.0 m/o 첨가의 ZYB5 시편은 입계에 유리상으로 보이는 2차상들이 상당히 많이 분리되어 있는데 이러한 2차상들은 유리상의 양이 증가할수록 증가하였다.

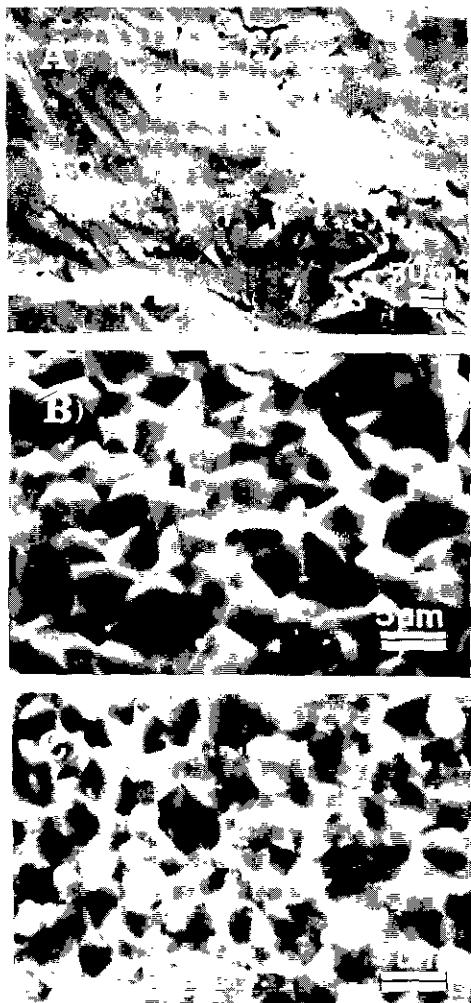


Fig. 1. SEM photographs of fracture surface of the samples; A) ZY8a, B) ZYB0, C) ZYB5.

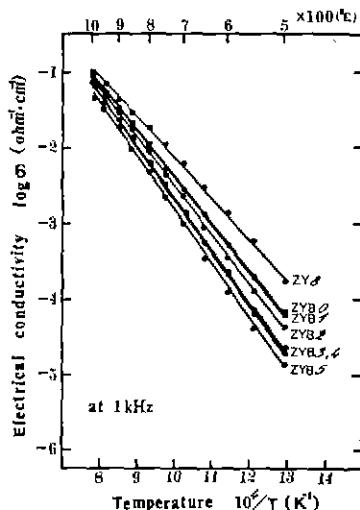


Fig. 2. Electrical conductivity vs. reciprocal temperature for the specimens fired at 1,300°C.

### III-2. 전기전도도

전기전도도 결과는 Fig. 2와 같다. 측정범위에서의 전기전도도는 아레니우스식  $\sigma = \sigma_0 \exp(-Q/RT)$ 에 따르며 이것의 활성화에너지는 Table 4와 같다. 여기서 보는 바와 같이 유리의 첨가량이 증가할수록 전기전도도는 감소하였으며 활성화에너지도 증가하였다. 이와 같은 경향을 나타내는 원인은 세 가지로 추정할 수 있는데 첫째는, 유리첨가로 인하여 입계에 형성된 유리상 및 이것의 분리에 의한 grainboundary effect이며 이것이 주된 영향을 미친다고 생각된다. Fig. 3에 이와 같은 분리현상의 대표적 예를 나타냈었는데 그림에서의 EDAX 분석용 시편은 다이아몬드 페이스트를 사용하여 1 μm 까지 절연마한 뒤 입자내부와 입계에서 방출되는 X-선 변화를 관찰한 것으로서 ZYB5 시편의 EDAX 자료에 의한 원소 조성을 Table 5에 실었다. Fig. 3의 region A의 분석결과 입계에 존재하는 2차상은 bismuth-silicate 성분이며, Bi 및 Si 원소가 입자내부까지 확산되어 있음이 확인되었다. 그러나 ZrKα 피크와 YKα 피크는 균점되어 있고 시편의 평균 임경이 3.4 μm 정도이므로 Table 5의 값은 대부분 정성적으로 봄이 타당하다.

둘째로는 망목구조내 남아있던 Si<sup>4+</sup>가 침입형자리에 들어가는 것과 관계가 있는 것으로 여겨진다. 즉 SiO<sub>2</sub>는 Kröger 표기에 의하면 다음 두 가지 형태로 표시할 수 있다.

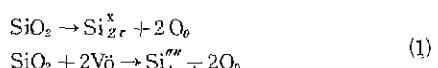
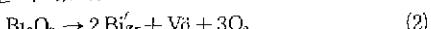


Table 4. Activation Energies for the Specimens.

Composition	Activation energy (K <sup>3</sup> / mol)
ZY8	101.8
ZYB0	116.4
ZYB1	117.0
ZYB2	124.3
ZYB3	129.4
ZYB4	131.1
ZYB5	135.2

다시 말해 Zr<sup>4+</sup> 격자자리에 Si<sup>4+</sup> 가 치환되거나 Si<sup>4+</sup> 가 침입형자리에 들어가 산소이온공격자를 감소시키면서 4가의 effective negative charge를 형성시키는 경우 인데 Si<sup>4+</sup>은 Zr<sup>4+</sup> 또는 Y<sup>3+</sup>에 비하여 이온반지름이 상당히 작으므로 Si<sup>4+</sup>은 거의 침입형자리에 들어갈 것으로 본다. 따라서 ZY8 자체를 산소이온공격자가 우세한 n형으로 간주한다면 산소이온공격자의 수는 감소하여 전기전도도는 저하한다.

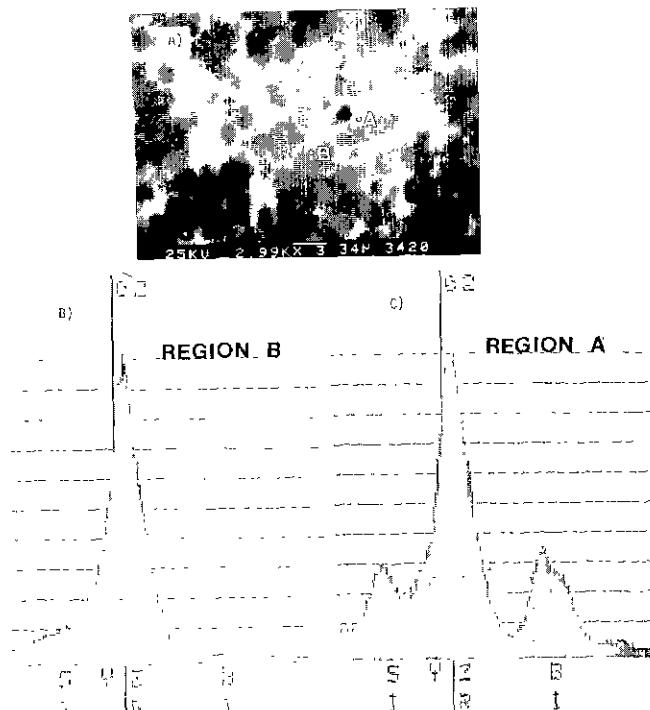
세제로 미워 받된 Bi<sup>3+</sup>들이 Zr 주격자내에서 치환된 것을 예상할 수 있다.



이것은 산소이온의 공격자가 생성됨으로 말미암아 전

Table 5. EDAX Analysis of Grain and Grainboundary Composition of the ZYB5  
(from Fig. 3)

Element	Grain ( point A )				Grain-boundary ( point B )			
	W/O	A/O	Oxide	Equiv. w/o	W/O	A/O	Oxide	Equiv. w/o
Zr K <sub>a</sub>	79.67	74.33	ZrO <sub>2</sub>	76.61	38.20	41.44	ZrO <sub>2</sub>	39.71
Bi L <sub>a</sub>	4.65	1.96	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.94	46.97	22.24	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	40.30
Y K <sub>a</sub>	15.83	15.68	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15.28	6.61	7.36	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.46
Si K <sub>a</sub>	2.56	8.03	SiO <sub>2</sub>	4.17	8.22	28.96	SiO <sub>2</sub>	13.53

Fig. 3. (ZrO<sub>3</sub>)<sub>0.92</sub>(Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>0.08</sub> sample containing 5 m/o bismuth-silicate glass; A) SEM photograph of polished surface, and EDAX spectra of B) region B, C) region A.

기전도도가 증가되는 경우이다. SEM사진 관찰시 유리양 증가에 따라 관찰된 2차상의 양은 매우 커 현저한 전기전도도 감소가 예상되었으나 Fig. 2의 전기전도도 감소 현상이 완만한 것은 (2)식에서 생성된  $V_0$  가 상기 두 가지 요인에 의한 전도도 감소를 일부 상쇄시켜 준 것으로 추측된다.

### III-3. 산소이온수송률

본 실험에 의한 산소농담전지의 이론적 배경은 다음과 같다.<sup>17)</sup>



이때 양단의 기전력, E는

$$E = \frac{1}{4F} \int \frac{\mu_{O_2}^I}{\mu_{O_2}^0} t_i d\mu_{O_2} \quad (4)$$

로 되는데 여기서  $\mu_{O_2}$ 는 산소의 화학포텐셜이고, F는 파라데이 상수이다. (4)식에서 산소이온수송률,  $t_i = 1$  일 때,

$$\begin{aligned} Ep &= \frac{ti}{4F} ((\mu_{O_2}^I - \mu_{O_2}^0) - (\mu_{O_2}^I - \mu_{O_2}^0)) \\ &= ti \frac{RT}{4F} \ln \frac{P_{O_2}^I}{P_{O_2}^0} \end{aligned} \quad (5)$$

가 된다. 여기서  $\mu_{O_2}^0$ 는 산소의 표준화학포텐셜이고  $P_{O_2}^I$  과  $P_{O_2}^0$ 는 양전극간의 산소분압이다.

산소이온수송률을 결과는 Fig. 4 와 같다. ZY8 시편은 소성온도에 무관하게 거의 1.0의 산소이온수송률을 나타냈으나 유리양이 증가할수록 산소이온수송률은 감소하였다. Fig. 4에서 특히 주목할만한 점은 ZYB0 시편의 경우 700 °C 이상의 온도에서는 산소이온수송률,  $t_i > 0.99$ 로 이론치에 거의 접근하고 있어 저온오성용 산소센서 소자로서 적합하다는 점이다. 모든 시편은 700 °C 이하의 온도에서는 산소이온수송률이 급격히 감소되고 있는데 이와 같은 미이상전위현상(non-

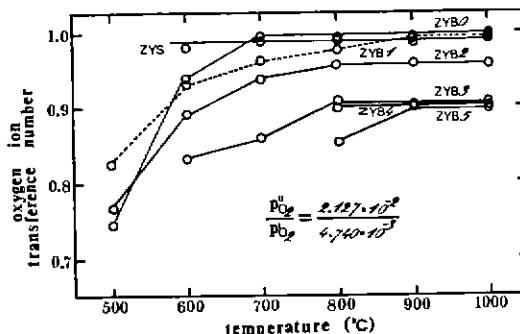


Fig. 4. Transport number versus temperature for the specimens fired at 1,300°C.

ideal behaviour)은 시편과 전극간의 전기화학적과정 또는 비평형화학반응 때문으로 여겨지는데 Franklin<sup>18)</sup>과 Brook 등은<sup>19)</sup>  $ZrO_2-CaO$ 계에 대하여 유사한 전극효과를 보고한 바 있다.

본 실험에서는 전기전도도의 산소분압의존성 및 최적 소결조건 등은 규명하지 않았지만, 앞으로 넓은 산소분압 범위에서의 센서 특징이 조사될 것으로 본다.

## IV. 결 론

8 m/o  $Y_2O_3$ -안정화자르코니아에  $Bi_2O_3$ 를 유리상으로 첨가한 본 실험 범위내에서 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 안정화자르코니아는  $Bi_2O_3$  첨가로서 300 °C 가량 낮은 소성온도에서 치밀화된다.
2.  $Bi_2O_3$  양이 증가할수록 필도는 감소하며 임계에 생성되는 2차상은 증가한다.
3. Bismuth-silicate 유리에서 유리된  $Bi^{3+}$ 는 임방정 자르코니아 격자내에서 치환형자리에  $Si^{4+}$ 는 침입형자리에 위치하고  $Si^{4+}$ 는 산소이온공격자 수를 감소시킨다.
4.  $Bi_2O_3$  양이 증가할수록 전기전도도와 산소이온수송률은 감소하고 활성화에너지에는 증가한다.
5.  $Bi_2O_3$ 는 유리화로 인하여 그 휘발이 약 60~80 % 정도 방지된다.
6. 유리중  $Bi_2O_3$  양을 0.5 m/o 첨가하였을 때의 산소이온수송률이 > 0.99로서, 고 산소분압에서의 저온 소성용 산소센서 소자로 적합하다.

## REFERENCE

1. J. F. Shackelford, P. S. Nicholson and W. W. Smeltzer, "Influence of  $SiO_2$  on Sintering of Particilly Stabilized Zirconia," *Bull. Am. Ceram. Soc.*, 53 (12) 865-7 (1974).
2. K. C. Radford and R. J. Bratton, "Zirconia Electrolyte Cells," *J. Mater. Sci.*, 14 59-64 (1979).
3. T. Takahashi, H. Iwahara and Y. Nagai, "High Oxide Ion Conduction in Sintered  $Bi_2O_3$  Containing  $SrO$ ,  $CaO$  or  $La_2O_3$ ," *J. Appl. Electrochem.*, 2 97-104 (1972).
4. T. Takahashi, H. Iwahara and T. Arao, "High Oxide Ion Conduction in Sintered Oxides of the System  $Bi_2O_3-Y_2O_3$ ," *ibid.*, 5 187-95 (1975).
5. T. Takahashi, T. Esaka and H. Iwahara, "Oxide Ion Conduction in the Sintered Oxides of  $MoO_3$ -Doped  $Bi_2O_3$ ," *ibid.*, 7 31-5 (1977).

6. T. Takahashi, T. Esaka and H. Iwahara, "Conduction in Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Based Oxide Ion Conductors under Low Oxygen Pressure. I. Current Blackening of the Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Electrolyte", *ibid.*, 7 299-302 (1977).
7. T. Takahashi, T. Esaka and H. Iwahara, "Conduction in Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - Based Oxide Ion Conductor under Low Oxygen-Pressure. II. Determination of the Partial Electronic Conductivity", *ibid.*, 7 303-8 (1977).
8. M. J. Verkerk and A. J. Burggraaf, "Free Energy of Formation of Stabilized Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (FCC) from e.m. f. Measurements", *ibid.*, 10 677-81 (1980).
9. K. Keizer, A. J. Burggraaf and G. De With, "The Effect of Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> on the Electrical and Mechanical Properties of ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Ceramics", *J. Mater. Sci.*, 17 1095-1102 (1982).
10. M. J. Verk, A. J. A. Winnubst and A. J. Burggraaf, "Effect of Impurities on Sintering and Conductivity of Yttria - Stabilized Zirconia", *ibid.*, 17 3113-22 (1982).
11. 정 형진, 오 영재, "이트리아를 함유한 자르코나 아 고체전해질의 물리적 전기적 특성", 본지, 23 (1)13~20 (1986).
12. 한국 공업 규격 KS L 3114 (1977).
13. Mel. I. Mendelson, "Average Grain Size in Polycrystalline Ceramics", *J. Am. Ceram. Soc.*, 52 (8) 443-6 (1969).
14. 清山 哲郎, 塩川 二朗, 鈴木 周一, 笠木和雄, "化學センサー その基礎と應用", pp. 135-143, 講談社 (1982).
15. H. Rawson, "Inorganic Glass-Forming System", pp. 203-6, Academic Press, London & New York (1967).
16. Bh. V. Janakirama Rao, "Dielectric Properties of Glass in the System Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - CdO - SiO<sub>2</sub>, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - CdO - Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - CdO - GeO<sub>2</sub> and Their Relation to the Structure of Glass", *J. Am. Ceram. Soc.*, 45 (II) 555-63 (1962).
17. 齊藤 安俊, "安定化 ジルコニアの電気導電と酸素センサ", ジルコニア セラミックス 1 pp. 109-125.
18. A. D. Franklin, "Electrode Effects in the Measurement of Ionic Conductivity", *J. Am. Ceram. Soc.*, 58 (11-12) 465-73 (1975).
19. R. J. Brook, W. L. Pelzmann and F. A. Kröger, "Platinum Electrodes and Calcia - Stabilized Zirconia", *J. Electrochem. Soc.*, 118 (2) 185-92 (1971).